
	<h2 style="color: red;">SI8810EDB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8810EDB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8810EDB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



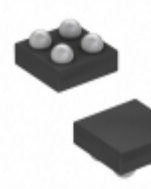


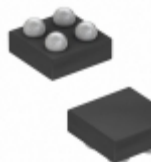

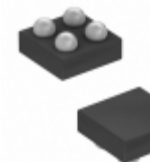
Spezifikationen

Teilenummer	SI8810EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	72 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Andere Namen	SI8810EDB-T2-E1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	245pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 500mW (Ta) Surface Mount 4-Microfoot
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8810EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8810EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8810EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8810EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8817DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8810EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>	 <p>SI8812DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8816EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>
 <p>SI8809EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p>	 <p>SI8808DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p>SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p>	 <p>SI8812DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8810EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / SI8810EDB-T2-E1 Datenblatt Vishay	SI8810EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8810EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8810EDB-T2-E1
SI8810EDB-T2-E1 Electronic	SI8810EDB-T2-E1-Komponenten	SI8810EDB-T2-E1-Verteiler	SI8810EDB-T2-E1-Bild
SI8810EDB-T2-E1 Preis	SI8810EDB-T2-E1 Hersteller	SI8810EDB-T2-E1 Bild	SI8810EDB-T2-E1 Aktie
SI8810EDB-T2-E1 Neu	SI8810EDB-T2-E1 Original	SI8810EDB-T2-E1 garantiert	SI8810EDB-T2-E1 RFQ
			SI8810EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited